

G – Personální zabezpečení – přednášející, školitel nebo člen oborové rady					
Název VŠ / součásti	Technická univerzita v Liberci				
Název SP / SO	Nanotechnologie				
Jméno a příjmení	Eduard Hulicius			tituly	prof., Ing. CSc.
Rok narození	1948	typ a rozsah prac. vztahu na VŠ		100%	do kdy
Přednášející	ano	školitel	ano	člen oborové rady	
Další současní zaměstnavatelé			typ prac. vztahu	rozsah	
FZÚ AVČR, v.v.i.			zaměstnanec	100%	
Přednášky v předmětech příslušného studijního programu					
Kapitoly z nanoelektroniky					
Údaje o oboru vzdělání na VŠ a o praxi od absolvování vysoké školy					
KIPL, FJFI-ČVUT (Ing.) ÚFPL ČSAV (CSc.) 1973 – dosud - Zaměstnání - FZÚ AV ČR, v. v. i. (dříve ÚFPL ČSAV, FZÚ ČSAV, FZÚ AV ČR)					
Přehled o nejvýznamnější publikační a další tvůrčí činnosti za posledních 5 let					
Od r. 2010 30 článků v mezinárodních impaktovaných časopisech; 49 příspěvků na zahraničních konferencích A. Hospodková, J. Pangrác, J. Vyskočil, M. Zíková, J. Oswald, Ph. Komninou, E. Hulicius Growth of InAs/GaAs quantum dots covered by GaAsSb in multiple structures studied by reflectance anisotropy spectroscopy J. Cryst. Growth 414 (2015) 156 - 160 M. Zíková, A. Hospodková, J. Pangrác, J. Oswald, P. Krčil, E. Hulicius, Ph. Komninou, J. Kioseoglou MOVPE prepared InAs/GaAs quantum dots covered by GaAsSb layer with long wavelength emission at 1.8 μm J. Cryst. Growth 414 (2015) 167 - 171 G.P. Dimitrakopoulos, C. Bazioti, J. Grym, P. Gladkov, E. Hulicius, J. Pangrác, O. Pacheroová, Ph. Komninou Misfit dislocation reduction in InGaAs epilayers grown on porous GaAs substrates Appl. Surf. Sci. 306 (2014) 89 - 93 A. Hospodková, M. Nikl, O. Pacheroová, J. Oswald, P. Brůža, D. Pánek, B. Foltynski, E. Hulicius, A. Beitlerová, M. Heuken InGaN/GaN multiple quantum well for fast scintillation application: radioluminescence and photoluminescence study Nanotechnology 25 (2014) 455501-1 - 455501-6.					

A. Hospodková, J. Pangrác, M. Zíková, J. Oswald, J. Vyskočil, Ph. Komninou, J. Kioseoglou, N. Florini, E. Hulicius Effect of the Lower and Upper Interfaces on the Quality of InAs/GaAs Quantum Dots Appl. Surf. Sci. 301 (2014) 173 - 177

Ph. Komninou, P. Gladkov, Th. Karakostas, J. Pangrác, O. Pacharová, J. Vaniš, E. Hulicius Structural and photoluminescent properties of low temperature InAs buffer layer grown by MOVPE on GaAs substrates J. Cryst. Growth 396 (2014) 54 - 60

M.P. Mikhailova, E.V. Ivanov, L.V. Danilov, A.A. Petukhov, K.V. Kalinina, S.I. Slobozhanyuk, G.G. Zegrya, N.D. Stoyanov, Yu.P. Yakovlev, A. Hospodková, J. Pangrác, J. Oswald, M. Zíková, E. Hulicius Two-band superlinear electroluminescence in GaSb based nanoheterostructures with AlSb/InAs_{1-x}Sb_x/AlSb deep quantum well J. Appl. Phys. 115 (2014) 223102(1) - 223102(5)

P. Morávek, J. Pangrác, M. Fulem, E. Hulicius, K. Růžicka Vapor pressures of (3-(Dimethylamino)propyl)dimethylindium, (tert-Butylimino)bis(diethylamino)cyclopentadienyltantalum, and (tert-Butylimino)tris(ethylmethylamino)tantalum J. Chem. Eng. Data 59 (2014) 4179 - 4183

J. Grym, D. Nohavica, P. Gladkov, E. Hulicius, J. Pangrác, K. Piksová Epitaxial growth on porous GaAs substrates C. R. Chim. 16 (2013) 59 - 64

P. Hazdra, J. Oswald, A. Hospodková, E. Hulicius, J. Pangrác Light emitting diodes with InAs/GaAsSb self-assembled quantum dot layer embedded in GaAs Thin Solid Films 543 (2013) 83 - 87

A. Hospodková, J. Oswald, J. Pangrác, M. Zíková, J. Kubištová, Ph. Komninou, J. Kioseoglou, K. Kuldová, E. Hulicius Combined vertically correlated InAs and GaAsSb quantum dots separated by triangular GaAsSb barrier J. Appl. Phys. 114 (2013) 174305(1) - 174305(5)

A. Hospodková, M. Zíková, J. Pangrác, J. Oswald, K.Kuldová, J. Vyskočil, E. Hulicius Graded GaAsSb strain reducing layers covering InAs/GaAs quantum dots J. Cryst. Growth 370 (2013) 303 - 306

A. Hospodková, M. Zíková, J. Pangrác, J. Oswald, J. Kubištová, K. Kuldová, P. Hazdra, E. Hulicius Type I - type II band alignment of GaAsSb/InAs/GaAs quantum dot heterostructure influenced by dot size and strain reducing layer composition J. Phys. D-Appl. Phys. 46 (2013) 095103(1) - 095103(6)

M. P. Mikhailova, I. A. Andreev, E. V. Ivanov, G. G. Konovalov, E. A. Grebentshikova, Yu. P. Yakovlev, E. Hulicius, A. Hospodková, J. Pangrác Photoelectric and Luminescence Properties of GaSb-Based Nanoheterostructures with a Deep Al(As)Sb/InAsSb/Al(As)Sb Quantum Well Grown by Metalorganic Vapor-Phase Epitaxy Semiconductors 47 (2013) 1041 - 5

P. Morávek, M. Fulem, J. Pangrác, E. Hulicius, K. Růžicka Vapor pressures of dimethylcadmium, trimethylbismuth, and tris(dimethylamino)antimony Fluid Phase Equilib. 360 (2013) 106 - 110

J. Walachová, J. Zelinka, S. Leshkov, F. Šroubek, J. Pangrác, E. Hulicius, J. Vaniš Integral and local density of states of InAs quantum dots in GaAs/AlGaAs heterostructure observed by ballistic electron emission spectroscopy near one-electron ground state Physica E 48 (2013) 61 - 65

M. P. Mikhailova, E. V. Ivanov, L. V. Danilov, K. V. Kalinina, N. D. Stoyanov, G. G. Zegrya, Yu. P. Yakovlev, E. Hulicius, A. Hospodková, J. Pangrác, M. Zíková Superlinear electroluminescence due to impact ionization in GaSb-based heterostructures with deep Al(As)Sb/InAsSb/Al(As)Sb quantum wells J. Appl. Phys. 112 (2012) 023108(1) - 023108(5)

D. Nohavica, J. Grym, P. Gladkov, E. Hulicius, J. Pangrác, Z. Jarchovský Thermal conversion and epitaxial overgrowth of nanopores etched in InP and GaAs Int. J. Nanotechnol. 9 (2012) 732 - 745

P. Gladkov, E. Hulicius, T. Paskova, E. Preble, K.R. Evans Below band-gap optical absorption and photoluminescence excitation spectroscopy at room temperature in low-defect-density bulk GaN:Fe Appl. Phys. Lett. 100 (2011) 031908(1 - 3)

Názvy disertačních prací, které vedl za posledních 5 let jako školitel

REFLEKTAČNÍ ANIZOTROPICKÁ SPEKTROSKOPIE AIIIIV MOVPE STRUKTUR, Ing. Jan Vyskočil, FEL ČVUT, školitel

Kvantové tečky, Ing. M. Zíková, FJFI ČVUT, školitel specialista

Působení v zahraničí

1977 FIAN - Moskva – 3 měsíce

1976 – 2004 FTI Petrohrad, IP Kyjev, FIAN Moskva, FI Novosibirsk – celkem 12 měsíců

1986 - University of Alberta – 4 měsíce

konference a krátkodobé pobyty – Evropa, USA, Japonsko, Indie, Austrálie, Kanada, Korea, JAR – rok

Obor habilitačního nebo jmenovacího řízení nebo udělení vědecké hodnosti	Aplikovaná fyzika		řízení na VŠ	
			FJFI - ČVUT	
			ohlasy publikací	
Rok udělení (prof...)	2012		ISI/Scopus	ostatní
Písemný souhlas přednáš., školitele, člena ob. rady s působ. v SP v daném rozsahu	Souhlasím		548	
		Datum	20.05. 2015	